

## 第50回 真空に関する連合講演会

**主 催：**日本真空協会

**協 賛：**映像情報メディア学会，応用物理学会，化学工学会，原子衝突研究協会，触媒学会，低温工学協会，電気学会，電子情報通信学会，日本化学会，日本加速器学会，日本機械学会，日本金属学会，日本顕微鏡学会，日本原子力学会，日本材料学会，日本質量分析学会，日本真空工業会，日本チタン協会，日本鉄鋼協会，日本半導体製造装置協会，日本表面科学会，日本物理学会，日本分析化学会，日本放射光学会，表面技術協会，腐食防食協会，プラズマ・核融合学会

**期 日：**平成21年11月4日（水）10：00-18：00

平成21年11月5日（木）9：00-17：45 懇親会18：00-19：30

平成21年11月6日（金）9：00-15：45

**会 場：**学習院創立百周年記念会館 3, 4F（東京都豊島区目白 1-5-1 目白キャンパス）

学習院アクセスマップウェブページ <http://www.gakushuin.ac.jp/map.html>

A 会場（口頭発表）3F 第1, 第2 会議室

B 会場（口頭発表）4F 第4 会議室

C 会場（ポスターセッション，企業展示）小講堂

懇親会場 学習院輔仁会館 2階さくらラウンジ

**参加費：**日本真空協会学生会員 2,000 円

日本真空協会個人会員及び法人会員に属する個人ならびに協賛学協会の会員 4,000円

非会員 5,000円

予稿集代金 2,500円

**入会のご案内：**日本真空協会学生会員の年会費は3,500円ですが，機関誌の配布を希望しない場合は2,000円になります．入会手続きについては，<http://wwwsoc.nii.ac.jp/vsj/OFFICE/officehome.html> の入会方法および入会申込書を参考にしてください．

**真空機器企業展示会および展示企業プレゼンテーション：**本年度もポスターセッション会場（C会場）において企業展示会（11月4日および11月5日）を開催いたします．是非お立ち寄り下さい．さらに，今回期間中に口頭発表会場にて展示企業プレゼンテーション（11月4日12：30-14：00予定）を開催します．詳細は上記協会ウェブページでお知らせします．

**企業展示出展：**25社程度出展予定．

第50回真空に関する連合講演会 会場スケジュール

	11/4(水)					11/5(木)					11/6(金)								
	A会場		B会場		C会場	A会場		B会場		C会場	A会場		B会場						
9:00						イナロ					6Aa-1		6Ba-1						
10:00	開会式 他	会長挨拶 他	田中正俊			シンポジウム	5Aa-1 井上泰志	櫻井岳暁			表面科学 I・ 応用表面科学	6Aa-2	吉武道子	6Ba-2		鷹野一朗			
		記念講演		5Aa-2 八瀬清志	6Aa-3		6Ba-3												
		5Aa-3 Gyou-Jin Cho	6Aa-4	6Ba-4															
		5Aa-4 近藤道雄	6Aa-5	6Ba-5															
11:00	真空口頭科学 I	4Aa-1 宅間宏	松本益明	薄口頭 I II	4Ba-1 4Ba-2 4Ba-3 4Ba-4	齊藤伸	6Aa-6	6Aa-7	6Aa-8	6Aa-9	6Aa-10 末光真希	薄口頭 III VII	6Ba-6 尾嶋正治	6Ba-7 6Ba-8 6Ba-9 6Ba-10	間瀬一彦				
12:00																			
13:00	企業プレゼン4A		黒岩雅英																
14:00											ポスターセッション II		5P-1~49 奇数番号 コアタイム			5P-1~49 偶数番号 コアタイム			
15:00																			
16:00																			
17:00	プラズマ科学 口頭 III	4Ap-1 齋藤永宏	岡本幸雄	真空科学 IV	4Bp-1 4Bp-2 4Bp-3 4Bp-4	齊藤芳男	ナノ構造 口頭 V	5Ap-1 木本浩司	吉本智巳	薄膜 II 表面工学 口頭 VI	5Bp-1 5Bp-2 5Bp-3 5Bp-4 古林孝夫	高橋研	表面科学 IX II	6Ap-1 近藤剛弘	中村健	薄膜 IV・電子材料 口頭 X	6Bp-1 6Bp-2 6Bp-3 6Bp-4 石塚尚吾	松倉祐輔	
		4Ap-2						5Ap-2						6Ap-2					
		4Ap-3						5Ap-3						6Ap-3					
		4Ap-4						5Ap-4						6Ap-4					
		4Ap-5						5Ap-5 松本和彦	板倉明子					6Ap-5	佐々木正洋				
18:00																			
19:00						懇親会 学習院輔仁会館2階さくらラウンジ													

第50回真空に関する連合講演会 受賞記念講演・シンポジウム・特別講演一覧

発表番号	講演題目	講演者	セッション名	期日	時間	会場
記念講演	硬質 BN 膜の切削工具への応用	野間正男 (神港精機㈱)	第34回真空技術賞受賞記念	11/4	10:15-10:45	A
4Aa-1	極高真空技術のニュー・トレンド	宅間 宏 (電気通信大)	真空科学・工学 I	11/4	11:00-11:30	A
4Ap-1	ソリューションプラズマ	齋藤永宏 (名古屋大エコトピア研)	プラズマ科学	11/4	16:15-16:45	A
4Bp-5	Vacuum performance of NEG coating in ESRF	Michael Hahn (ESRF)	真空科学・工学 II	11/4	17:15-17:45	B
5Aa-1	ナノ構造制御の新展開: 微絨毛状ナノ構造化による吸着誘起型エレクトロクロミック特性の向上	井上泰志 (名古屋大エコトピア研)	シンポジウム	11/5	9:05-9:45	A
5Aa-2	印刷エレクトロニクスの現状と展望: 全印刷法による有機 TFT アレイ化技術	八瀬清志 (産総研)	シンポジウム	11/5	9:45-10:25	A
5Aa-3	Roll-to-Roll Printed 13.56 MHz Operated RFID-Sensor-Display Tags	Gyou-Jin Cho (Sunchon National University, Korea)	シンポジウム	11/5	10:40-11:20	A
5Aa-4	薄膜太陽電池の現状と展望	近藤道雄 (産総研)	シンポジウム	11/5	11:20-12:00	A
5Ap-1	透過電子顕微鏡による原子選択イメージング	木本浩司 (物材機構)	ナノ構造	11/5	15:15-15:45	A
5Ap-5	CNT-FET を用いたバイオセンサー	松本和彦 (大阪大産研)	ナノ構造	11/5	16:45-17:15	A
5Bp-4	ハーフメタル薄膜の作成と応用	古林孝夫 (物材機構)	薄膜 II・表面工学	11/5	16:00-16:30	B
5Bp-7	常温接合法の開発と微細接合への応用	須賀唯知 (東京大)	薄膜 II・表面工学	11/5	17:15-17:45	B
6Aa-10	Si 系薄膜の成膜機構の原子・分子レベルでの解明と低温・高品質形成を実現する新たな成膜技術の創生	末光眞希 (東北大電通研)	表面科学 I・応用表面科学	11/6	11:30-12:00	A
6Ba-6	放射光を用いた光電子分光による半導体プロセスにおける薄膜成長の解析	尾嶋正治 (東京大)	薄膜 III	11/6	10:30-11:00	B
6Ap-1	グラファイト表面上の単原子層 Pt 触媒	近藤剛弘 (筑波大)	表面科学 II	11/6	13:00-13:30	A
6Bp-4	CIGS 系太陽電池の開発	石塚尚吾 (産総研)	薄膜 IV・電子材料・プロセス	11/6	13:45-14:15	B

# プログラム

—11月4日(水)—

## A会場 午前の部

【開会式・表彰式・受賞記念講演】 10:00~10:45

開会の挨拶・表彰式 10:00~10:15

受賞記念講演 10:15~10:45

真空技術賞 硬質 BN 膜の切削工具への応用 …………… (神港精機㈱\*1・滋賀県東北部工技センター\*2・滋賀県立大\*3)  
°野間正男\*1・柏原哲隆\*1・玉岡克康\*1・小松永治\*1・所 敏夫\*2・  
大西宏明\*2・小川圭二\*3・中川平三郎\*3

休 憩

## A会場 午前の部

口頭発表 I 【真空科学・工学 I】 11:00~12:00

4Aa-1 【特別講演】

極高真空技術のニュー・トレンド…………… (電気通信大) 宅間 宏

4Aa-2 焼結フィルターを用いた混合ガスの標準リーク …………… (産総研) °吉田 肇・新井健太・平田正紘・秋道 斉

4Aa-3 温度場によって誘起される希薄気体の流れを用いた気体分離装置 …………… (京都大院工) °杉元 宏・篠遠 晃

## B会場 午前の部

口頭発表 II 【薄膜 I】 11:00~12:00

4Ba-1 NiO-ReRAM の電気特性の電極材料及びその結晶性への依存性  
…………… (鳥取大工) °土橋一史・牧野達也・花田明紘・奥谷 匠・依田貴稔・木下健太郎・岸田 悟

4Ba-2 MgO スパッタ膜の電子放出特性と絶縁破壊特性の製膜時圧力依存性  
…………… (成蹊大理工) °新井 完・関谷賢明・中野武雄・馬場 茂

4Ba-3 希薄磁性半導体 GaGdN の作製とその物性評価  
…………… (大阪大産研) °谷 弘敦・長谷川繁彦・周 逸凱・江村修一・朝日 一

4Ba-4 薄膜ヤング率の膜厚依存性及び環境応答性について  
…………… (物材機構\*1・東北大工\*2・東京理大工\*3) °板倉明子\*1・戸田雅也\*2・佐々木信也\*3

休 憩

## A会場 昼の部

展示企業プレゼンテーション【4A】 12:30~14:00

## B会場 昼の部

展示企業プレゼンテーション【4B】 12:30~14:00

C会場ポスターセッション I 14:00~16:00 (奇数番コアタイム 14:00~15:00 偶数番コアタイム 15:00~16:00)

【真空科学・工学・プラズマ科学・表面科学・表面工学・薄膜】

4P-1 シールエッジ部を電子ビーム改質したアルミフランジの調査  
… (財高輝度光科学研究センター) °大石真也・小路正純・岡安雄一・谷内友希子・米原博人・大熊春夫

4P-2 加速器ビームダクトへの MO フランジの応用 3—実機加速器での経験および銅・アルミ合金フランジの適  
用— …………… (高エネ研\*1・㈱オオツカ\*2・コミヤマエレクトロニクス\*3・金属技研㈱\*4)  
°末次祐介\*1・白井 満\*1・大塚美智夫\*2・西殿敏朗\*3・渡邊一彦\*3・鈴木康明\*4・森 重晶\*4・  
土屋将夫\*4・米本朋弘\*4

4P-3 無酸素銅製放射光アブゾーバの腐食現象 …………… (高エネ研) 内山隆司・野上隆史・谷本育律・°本田 融

4P-4 耐放性 TMP の磁場による渦電流損の評価 …………… (日本原研) °金澤謙一郎・瀧山陽一・柳橋 亨・荻原徳男

4P-5 長い導管からの気体流入がある真空容器の圧力変化  
…………… (東京電機大学\*1・高エネ研\*2) °松田七美男\*1・佐藤吉博\*2・齊藤芳男\*2

4P-6 拡散方程式の定常解に基づく分子流コンダクタンス値  
…………… (東京電機大学\*1・高エネ研\*2) °松田七美男\*1・佐藤吉博\*2・齊藤芳男\*2

4P-7 回転円盤による排気特性…………… (日本原研) 荻原徳男

4P-8 J-PARC RCS 用ピラニ真空計…………… (日本原研) °荻原徳男・引地裕輔

4P-9 隔膜真空計の熱遷移と校正 …………… (産総研) °平田正紘・吉田 肇・小島桃子・新井健太・秋道 斉

4P-10 B-A 真空計の電極配置と感度係数の関係 …………… (産総研) °杉沼茂実・平田正紘

- 4P-11 超広域ガス放出速度測定装置の考案 …………… (山口大院理工\*1・キヤノンアネルバ<sup>株</sup>\*2)  
 °栗巢普揮\*1・竹田将利\*1・山田 純\*1・高田直己\*1・山本節夫\*1・古屋誠司\*2・  
 中澤健二\*2・正木宣行\*2
- 4P-12 気液平衡型ガス発生源の真空天秤による性能試験  
 …… (日本原研\*1・ガステック\*2) °秦野歳久\*1・平塚 一\*1・長谷川浩一\*1・海福雄一郎\*2・阿部哲也\*1
- 4P-13 水晶振動子センサーによるシラン-水素混合気体中のシラン濃度比測定  
 …………… (産総研) °鈴木 淳・柄澤 稔・永井武彦・野中秀彦・近藤道雄
- 4P-14 キャピラリーによるイオンビームの収束と計測方法  
 …………… (産総研) °渡辺幸次・近藤貢二・藤原幸雄・齋藤直昭・野中秀彦・一村信吾
- 4P-15 欧州規格 EN13192:2002による標準リークの比較校正  
 …………… (産総研計測標準) °新井健太・吉田 肇・秋道 斉・平田正紘
- 4P-16 膨張法装置の膨張比の測定 …………… (産総研) °小松栄一・秋道 斉・平田正紘
- 4P-17 極限環境下で使用される材料からの光電子放出分布の測定  
 …………… (埼玉大理工\*1・宇宙航空研\*2) °生井諭司\*1・山納 康\*1・小林信一\*1・仁田工美\*2
- 4P-18 真空中における PET フィルムとアルミナ絶縁体の AC 印加電圧による帯電分布  
 …………… (埼玉大院理工) °山崎悠樹・小林信一・山納 康
- 4P-19 微小材料機械強度試験装置の開発 …………… (物材機構) °笠原 章・鈴木 裕・荒木 弘・後藤真宏・土佐正弘
- 4P-20 保管方法・保管期間の異なる無酸素銅電極の真空中絶縁破壊特性  
 …………… (埼玉大\*1・高エネ研\*2) °明石圭祐\*1・小林信一\*1・山納 康\*1・齋藤芳男\*2
- 4P-21 Ar プラズマ中における金属の電気特性に関する研究 V …………… (広島国際学院大工総合工) 久保 隆
- 4P-22 炭酸ガスレーザー励起酸素プラズマからの極端紫外線分光  
 …………… (神戸大院\*1・宇宙航空研\*2・大阪大レーザーエネルギー学研究中心\*3)  
 °田川雅人\*1・横田久美子\*1・島村宏之\*2・木本雄吾\*2・古賀真由子\*3・西村博明\*3
- 4P-23 容量結合型キャピラリープラズマ源 …………… (鶴岡高専) °吉木宏之・石山 謙・平田慎太郎
- 4P-24 熱電対を用いた原子状酸素の再結合係数測定装置の開発  
 …………… (株)アルバック筑波超材研\*1・同電子機器事業部\*2・同技術開発部\*3)  
 °榎藤麻衣子\*1・石樽文昭\*1・稲吉さかえ\*1・三浦 豊\*2・小方誠司\*3
- 4P-25 金属内包フラーレン合成用電子サイクロトロン共鳴イオン源のプラズマの評価  
 …………… (立山マシン\*1・東洋大バイオナノ\*2・東洋大工\*3・放医研\*4・大阪大院工\*5)  
 °田中清勝\*1・内田貴司\*2,\*3・峰崎英和\*3・内山英史\*1・浅地豊久\*1・村松正幸\*4・  
 北川敦志\*4・加藤裕史\*5・吉田善一\*2,\*3
- 4P-26 Si(111)-( $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ )-Ag 表面上に配列したオリゴチオフェン分子の低温 STM 観察  
 …………… (横浜国大工\*1・横浜市大国際総合科学\*2) °浅利友隆\*1・横山 崇\*2・大野真也\*1・田中正俊\*1
- 4P-27 オリゴチオフェン超薄膜成長過程における配向変化の解析 …………… (横浜大工\*1・横浜市大国際総合\*2)  
 °井上 慧\*1・脇田 創\*1・浅利友隆\*1・西山文貴\*2・横山 崇\*2・大野真也\*1・田中正俊\*1
- 4P-28 金属表面上メタン解離吸着過程における欠陥の影響  
 …………… (筑波大数理物質科学) °菅原千尋・横山有太・岡田隆太・山田洋一・佐々木正洋
- 4P-29 NO と CO の共吸着した Ir(111) 表面に関する研究  
 …………… (東京大生産研) °松本益明・池田暁彦・福谷克之・岡野達雄
- 4P-30 微分型 SDR スペクトルにおける電場効果の解析  
 …………… (横浜国大工\*1・防衛大\*2) °落合俊之\*1・大野真也\*1・鈴木隆則\*2・田中正俊\*1
- 4P-31 金属表面上での水素分子のオルソ・パラ転換ダイナミクス  
 …………… (大阪大院工) °國貞雄治・中西 寛・笠井秀明
- 4P-32 NaCl(100) 表面上の Al ナノワイヤーの原子配置と電子状態  
 …………… (岡山理科大院工\*1・岡山理科大\*2・岡山理科大工\*3) °横矢 哲\*1・加地博子\*2・垣谷公徳\*3
- 4P-33 Pd(111) 表面及び表面内部領域に入射した水素原子の量子ダイナミクス  
 …………… (大阪大院工) °尾澤伸樹・中西 寛・笠井秀明
- 4P-34 Si 上に原子状水素を吸着させた H/Si(111) 面の電子-電子コインシデンス分光 (APECS) 測定  
 …………… (横浜国大院工\*1・KEK 物構研\*2) °山崎貴彦\*1・橋本章吾\*1・間瀬一彦\*2・田中正俊\*1
- 4P-35 高温 Si(001) 表面上のカリウム原子の動的挙動のリアルタイム観測  
 …………… (横浜国大工\*1・防衛大応物\*2) °森本真弘\*1・大野真也\*1・鈴木隆則\*2・田中正俊\*1

- 4P-36 イオン結晶表面ステップにより誘起される最表面の格子歪み  
 ..... (大阪教育大理科教育) °深澤優子・池本将健・柴田 卓・鈴木康文
- 4P-37 低エネルギーイオンビーム照射による PTFE 表面の撥水特性変化  
 ..... (理研\*1・工学院大工\*2) °佐々木道子\*1・大森 整\*1・鷹野一朗\*2
- 4P-38 磁性原子吸着系における近藤効果と RKKY 相互作用の競合の STS 観察  
 ..... (大阪大院工\*1・大阪大院理\*2) °南谷英美\*1・中西 寛\*1・Wilson Agerico Dino\*2・笠井秀明\*1
- 4P-39 SPring-8 BL23SU の表面化学反応分析装置における実空間“その場”観察の実現  
 ..... (日本原研) °吉越章隆・寺岡有殿
- 4P-40 同軸型直線導入機を用いた試料搬送導入機の開発  
 ..... (九州シンクロトロン光研究センター\*1・真空光学\*2)  
 °小林英一\*1・瀬戸山寛之\*1・岡島敏浩\*1・明角淳志\*2
- 4P-41 Polyimide (PI) 系プラズマ蒸着重合膜の構造解析 ..... (金沢大自然科学\*1・岩崎電気\*2・産総研\*3)  
 °杉本亮祐\*1・長田幸輔\*1・倉田昌彦\*1・松本裕之\*1,\*2・岩森 暁\*1・野田和俊\*3
- 4P-42 ポリ(3-オクチルチオフェン) [P3OT] を用いたポリ(3-ヘキシルチオフェン) [P3HT] /PCBM 複合膜の  
 ナノモロフォロジー制御とその複合膜の有機太陽電池性能評価  
 ..... (愛知工業大\*1・名古屋大\*2) °酒井健太\*1・小嶋憲三\*1・水谷照吉\*2・落合鎮康\*1
- 4P-43 Poly(etheretherketon) (PEEK) をターゲットとして高周波スパッタリングにより作製した薄膜の構造  
 ..... (金沢大自然科学\*1・成蹊大理工\*2)  
 °内田大字\*1・長谷川周彦\*1・祖父江英哲\*1・岩森 暁\*1・斉藤洋司\*2
- 4P-44 溶液法を用いた有機薄膜太陽電池の作製と評価  
 ..... (愛知工業大\*1・名古屋大\*2) °石原啓史\*1・小嶋憲三\*1・水谷照吉\*2・落合鎮康\*1
- 4P-45 アモルファスフッ素樹脂をゲート絶縁膜とした有機電界効果トランジスタ  
 ..... (愛知工業大) °北島洋輔・落合鎮康・小嶋憲三・水谷照吉
- 4P-46 イオンビームアシスト法によるトルエン雰囲気中での Si-DLC 薄膜の作製と機械的特性  
 ..... (工学院大工) °原 知之・鷹野一朗
- 4P-47 ナフタレン雰囲気中のイオンアシストにより作製した DLC 薄膜への Ti 添加効果  
 ..... (工学院大工) °成田真一・鷹野一朗
- 4P-48 高水素化 DLC フィルムへの紫外線照射による脱水素化反応  
 ..... (神戸大院\*1・宇宙航空研\*2・兵庫県立大高度研\*3・神戸大院\*4)  
 °横田久美子\*1・田川雅人\*1・松本康司\*2・神田一浩\*3・北村 晃\*4
- 4P-49 MPCVD 法によるダイヤモンド初期成長過程と界面の構造 ..... (長崎総合科学大工) 吉田昌平・°奥野公夫
- 4P-50 透過型電子顕微鏡用環境セルに用いる B-C-N-O 系非結晶隔膜の作製  
 ..... (近畿大院総合理工\*1・近畿大理工学\*2・名古屋大院工\*3) °筒井秀徳\*1・松谷貴臣\*2・川崎忠寛\*3

**A会場 午後の部**

**口頭発表Ⅲ【プラズマ科学】 16:15~18:00**

- 4Ap-1 **【特別講演】**  
 ソリューションプラズマ..... (名古屋大エコトピア科学研) 齋藤永宏
- 4Ap-2 H<sub>2</sub> と N<sub>2</sub> ガスにおける光電子制御プラズマの放電特性 ..... (東北大多元研\*1・CREST-JST\*2・富士通\*3)  
 °大友悠大\*1・加賀利瑛\*1・小川修一\*1,\*2・佐藤元伸\*2,\*3・二瓶瑞久\*2,\*3・高桑雄二\*1,\*2
- 4Ap-3 光電子制御プラズマ放電特性の Ar ガス圧力依存 ..... (東北大\*1・CREST-JST\*2・富士通\*3)  
 °加賀利瑛\*1・大友悠大\*1・小川修一\*1,\*2・佐藤元伸\*2,\*3・二瓶瑞久\*2,\*3・高桑雄二\*1,\*2
- 4Ap-4 分光法を用いた Ar 励起原子温度測定 ..... (北海道大院工) °本家 翼・西山修輔・富岡 智・日野友明
- 4Ap-5 シミュレーションを用いた誘導性総合型フロロカーボンプラズマの解析及び検討  
 ..... (中部大学工\*1・ペガサスソフトウェア\*2)  
 長田広光\*1・早河建佑\*1・中村圭二\*1・板津史明\*1・田中清明\*2

**休 憩**

**B会場 午後の部**

**口頭発表Ⅳ【真空科学・工学Ⅱ】 16:15~17:45**

- 4Bp-1 電子銃カソード面へのイオン流入 ..... (株アルバック) °渡辺将也・楠本淑郎
- 4Bp-2 チタン材料に溶存した水素の放出機構 ..... (山口大院理工\*1・株UBE 科学分析センター\*2)  
 °竹田将利\*1,\*2・栗巣普揮\*1・山本節夫\*1・中川浜三\*2

- 4Bp-3 チタン材料における水のガス放出低減に関する研究開発 …………… (山口大院理工\*1・三愛プラント工業㈱\*2)  
竹田将利\*1・°栗巢普揮\*2・内田貴士\*1・山本節夫\*1・石澤克修\*2・野村 健\*2・江田庸宏\*2・村重信之\*2
- 4Bp-4 超高真空装置内における水分子流の導入・排気特性  
…………… (Inst. Industrial Science, Univ. Tokyo) °Toshiki Sugimoto, Katsuyuki Fukutani
- 4Bp-5 【特別講演】  
Vacuum performance of NEG coating in ESRF  
…………… (European Synchrotron Radiation Facility) Michael Hahn

—11月5日(木)—

A会場 午前の部

シンポジウム「光を制御する機能性薄膜の最前線」9:00~12:00

- 5Aa-1 ナノ構造制御の新展開：微絨毛状ナノ構造化による吸着誘起型エレクトロクロミック特性の向上  
…………… (名古屋大学エコトピア) 井上泰志
- 5Aa-2 印刷エレクトロニクスの現状と展望：全印刷法による有機 TFT アレイ化技術 …………… (産総研) 八瀬清志
- 休憩
- 5Aa-3 Roll-to-Roll Printed 13.56 MHz Operated RFID-Sensor-Display Tags  
…………… (Sunchon National University, Korea) Gyou-Jin Cho
- 5Aa-4 薄膜太陽電池の現状と展望…………… (産総研) 近藤道雄

休憩

C会場ポスターセッションII 13:00~15:00 (奇数番コアタイム 13:00~14:00 偶数番コアタイム 14:00~15:00)

【薄膜・ナノ構造・応用表面科学・表面工学・電子材料・プロセス】

- 5P-1 酸化物超伝導体 BSCCO の仕事関数 … (東京理大工) °江澤正晃・都築達也・佐藤勝利・宇原祥夫・斉藤 茂
- 5P-2 光電子収量分光における2次電子閾値の検討  
…………… (物材機構半導体材料センター) °柳生進二郎・吉武道子・金 兌映・知京豊裕
- 5P-3 マイクロ電子ビーム蒸着法による金属蒸着  
…………… (物材機構) °金 兌映・吉武道子・柳生進二郎・ネムシャク スラボミル・知京豊裕
- 5P-4 重水素イオン注入した水素貯蔵材 (V<sub>25</sub>Cr<sub>40</sub>Ti<sub>35</sub>) の高分解能軟 X 線放射光光電子分光による自然酸化膜の熱安定性の評価 …………… (日本原研\*1・大阪大院理\*2・兵庫県立大理\*3)  
°戸出真由美\*1・James R. HARRIES\*1・寺岡有殿\*1・角本雄一\*1\*2・井上敬介\*1,\*3・吉越章隆\*1
- 5P-5 炭素負イオン注入による CHF<sub>3</sub> プラズマ処理石英ガラス上での間葉系幹細胞のパターン接着  
…………… (京都大院工) °辻 博司・Piyanch Sommani・佐藤弘子・後藤康仁・高岡義寛
- 5P-6 Fine Adhesion Patterning and Aligned Nuclei Orientation of Mesenchymal Stem Cell on Narrow Line-Width of Silicone Rubber Implanted by Carbon Negative Ions …………… (Kyoto Univ., Fac. of Eng.)  
°Sommani Piyanch, Tsuji Hiroshi, Sato Hiroko, Gotoh Yasuhito, Gikan Takaoka
- 5P-7 ウェブベースの金属偏析予測システム…………… (物材機構) 吉武道子
- 5P-8 種々のイオン照射による PTFE 表面形態の撥水性への影響  
…………… (工学院大工\*1・理研\*2) °葛川友佑\*1・佐々木道子\*2・鷹野一朗\*1
- 5P-9 軌道曝露試験した固体潤滑剤被覆の性能評価 …………… (物材機構) °土佐正弘・笠原 章・後藤真宏
- 5P-10 c-BN コート工具の工具形状依存性  
…………… (神港精機㈱\*1・兵庫県立工技センター\*2・滋賀県東北部工技センター\*3)  
°野間正男\*1・山下 満\*2・今田琢巳\*3・所 敏夫\*3
- 5P-11 メタノール中の通電により堆積した DLC/W 単一陰極からの電界放射の熱処理による変化  
…………… (東洋大院機能システム\*1・東洋大バイオナノ\*2・東京大生産研\*3)  
°宇賀神佳晃\*1・吉本智巳\*1,\*2・岩田達夫\*3
- 5P-12 FIB により先端を先鋭化した p-Si 単一陰極からの電子放射  
…………… (東洋大院機能システム\*1・東洋大バイオナノ\*2) °佐藤和喜\*1・吉本智巳\*1,\*2
- 5P-13 タングステンエミッタの電界電子放出の安定性向上に向けた取り組み  
…………… (京都大院工電子) °河崎道人・後藤康仁・辻 博司
- 5P-14 微細磁性ドットの作製とその形状評価 …………… (秋田県産技総研センター高度技研) °有明 順・近藤祐治
- 5P-15 ナノカーボン材料を対象とした電子ビーム誘起構造変化の分子シミュレーション  
…………… (大阪府立大院工) °和久田真也・安田雅昭・三村亮介・川田博昭・平井義彦

- 5P-16 AFM 像探針形状効果補正のための標準ナノ粒子法とブラインド法の比較  
 ..... (物材機構ナノ計測センター) °大西桂子・藤田大介
- 5P-17 集束イオンビームによる走査型透過電子顕微鏡用輪帯アパーチャの開発  
 ..... (近畿大\*1・大阪産業大\*2・大阪大\*3・名古屋大\*4・大阪電通大\*5)  
 °松谷貴臣\*1・田中武雄\*2・木村吉秀\*3・高井義造\*3・川崎忠寛\*4・市橋幹雄\*4・生田 孝\*5
- 5P-18 超高真空スパッタ装置での微細孔への銅埋め込みにおける窒素添加の影響  
 ..... (東京理科大工電気) °伊藤勝利・浦野 翼・松田真二・溝上充罔・宇原祥夫・斉藤 茂
- 5P-19 エアロゾルデポジション法による銅皮膜の作製と評価  
 ..... (豊橋技科大\*1・新東プレーター\*2) °山田基宏\*1・鈴木卓朗\*1・福本昌宏\*1・山口英二\*2
- 5P-20 パルスレーザー堆積法により SnO<sub>2</sub> 系材料を用いて作製した積層型透明導電膜  
 ..... (大阪産業大工\*1・奥田技術事務所\*2)  
 °安居利将\*1・青木孝憲\*1・松下辰彦\*1・鈴木晶雄\*1・奥田昌宏\*2
- 5P-21 反応性スパッタリングによる Pd 添加 WO<sub>3</sub> 薄膜の光学的特性  
 ..... (明治大理工) °籾本泰平・岩井祐貴・三浦 登・松本節子・中野遼太郎・松本皓永
- 5P-22 反応性スパッタリング法により作製された酸化タングステン薄膜の結晶構造と光学的特性の関係  
 ..... (工学院大工) °サルマド イブラヒム・鷹野一朗
- 5P-23 高速低温スパッタ法による TiO<sub>2</sub> 光触媒薄膜の成膜技術開発  
 ..... (都城高専物質工) °奥津加奈・鬼束さおり・野口大輔
- 5P-24 BaTiO<sub>3</sub> 薄膜の配向制御  
 ..... (鳥取大工\*1・鳥取県産技センター\*2・鳥取大工電子ディスプレイ研究センター\*3)  
 °出口恭平\*1・吉田大一郎\*1,2・花田明紘\*1・木下健太郎\*1,3・岸田 悟\*1,3
- 5P-25 中止
- 5P-26 アナターゼ型 TiO<sub>2</sub> 薄膜への窒素イオン注入が及ぼす光機能特性への影響  
 ..... (工学院大工) °田中啓太・鷹野一朗
- 5P-27 反応性スパッタリング法による TiO<sub>2</sub> 薄膜への W 添加の影響  
 ..... (工学院大工) °シュクル ハイデル アリ・佐藤光史・鷹野一朗
- 5P-28 Ar 雰囲気下での銅フタロシアニン微粒子の結晶成長 ..... (名古屋工業大) °岩津文夫・森島章仁・平松良規
- 5P-29 MHV スパッタ装置により作製した薄膜の特性  
 ..... (㈱岡野製作所\*1・大阪府立産技総研\*2・小川創造技研\*3・大阪市立大\*4)  
 °岡野夕紀子\*1・田尻修一\*1・青園隆司\*1・岡本昭夫\*2・小川倉一\*3・美馬宏司\*4
- 5P-30 スパッタ法により作製した CrSiC 系複合薄膜における電気的特性の膜厚依存性  
 ..... (㈱アサヒ電子研\*1・日本リニアックス㈱\*2・大阪府立産技総研\*3・小川創造技研\*4)  
 °近藤真也\*1・玉置 肇\*1・竹中 宏\*2・笥 芳治\*3・小川倉一\*4
- 5P-31 CrSiC 系複合薄膜による高性能力覚センサの試作  
 ..... (㈱アサヒ電子研\*1・日本リニアックス㈱\*2・大阪府立産技総研\*3・小川創造技研\*4)  
 近藤真也\*1・玉置 肇\*1・竹中 宏\*2・武村 守\*3・小川倉一\*4
- 5P-32 スパッタ法による  $\mu\text{c(a)-SiC:H}$  薄膜特性における高周波電力依存性  
 ..... (宮崎大) 山脇翔太・齋藤順雄・前田幸治・西岡賢祐
- 5P-33 サファイア基板上 InSb 薄膜の電気的および熱電特性に対するスパッタ法成膜 InAs バッファ層の効果  
 ..... (神奈川大院工電気電子情報工) °本間秀幸・長田浩尚・山口栄雄
- 5P-34 ポリ(3-オクチルチオフェン)/PCBM 複合膜を用いた有機薄膜太陽電池の作製とその性能評価  
 ..... (愛知工業大\*1・名古屋大学\*2) °島戸信也\*1・小嶋憲三\*1・水谷照吉\*2・落合鎮康\*1
- 5P-35 RF スパッタリング法を用いた太陽電池用表面電極の特性と改善  
 ..... (大阪産大工\*1・奥田技術事務所\*2) °張貴峰\*1・青木孝憲\*1・松下辰彦\*1・鈴木晶雄\*1・奥田昌宏\*2
- 5P-36 TZO 薄膜透明導電膜の低抵抗率化  
 ..... (大阪産大工\*1・奥田技術事務所\*2) °酒井拓也\*1・青木孝憲\*1・松下辰彦\*1・鈴木晶雄\*1・奥田昌宏\*2
- 5P-37 有機基板上的バッファ層付亜鉛系透明導電膜の最適化  
 ..... (大阪産大工\*1・奥田技術事務所\*2) °上野優樹\*1・青木孝憲\*1・松下辰彦\*1・鈴木晶雄\*1・奥田昌宏\*2
- 5P-38 超薄膜領域における PLD 法で作製したガリウム添加酸化亜鉛透明導電膜  
 ..... (大阪産大工\*1・奥田技術事務所\*2) °兼田真司\*1・青木孝憲\*1・松下辰彦\*1・鈴木晶雄\*1・奥田昌宏\*2
- 5P-39 シクロオレフィンポリマー基板上に成膜した AZO/ZnO 透明導電膜の AZO 膜の超薄膜化  
 ..... (大阪産大工\*1・奥田技術事務所\*2) °一井直弥\*1・青木孝憲\*1・松下辰彦\*1・鈴木晶雄\*1・奥田昌宏\*2



- 5P-40 プラスチック基板への酸化亜鉛系透明導電膜へのレーザーアニーリングによる特性改善  
 … (大阪産大工\*1・奥田技術事務所\*2) °上西俊道\*1・青木孝憲\*1・松下辰彦\*1・鈴木晶雄\*1・奥田昌宏\*2
- 5P-41 酸化亜鉛系透明導電膜への Nd:YAG レーザーによるアニーリング効果  
 … (大阪産大工\*1・奥田技術事務所\*2) °中村圭太\*1・青木孝憲\*1・鈴木晶雄\*1・松下辰彦\*1・奥田昌宏\*2
- 5P-42 RF マグネトロンスパッタ法により可塑性樹脂基板上に成膜した ZnO 膜の物性評価  
 ……………… (東京電機大工) °井上竜ノ介・松田七美男・蔵本翔太郎
- 5P-43 RF スパッタリング法により作製した ZnO 薄膜の光学的性質  
 ……………… (明治大) °藤田直人・岩井祐貴・松本皓永・松本節子
- 5P-44 酸化亜鉛系材料を用いた積層型透明導電膜の特性  
 … (大阪産大工\*1・奥田技術事務所\*2) °生田公洋\*1・青木孝憲\*1・松下辰彦\*1・鈴木晶雄\*1・奥田昌宏\*2
- 5P-45 高移動度、低キャリア密度 ZnO 系透明導電膜の作製  
 … (大阪産大工\*1・奥田技術事務所\*2) °中村吉伸\*1・青木孝憲\*1・松下辰彦\*1・鈴木晶雄\*1・奥田昌宏\*2
- 5P-46 Influence of oxygen gas introduction on electrical property of Ag thin films used in low-emissivity  
 ……………… (セントラル硝子(株)硝子研) °加藤和広・大本英雄・高松 敦
- 5P-47 中止
- 5P-48 新型光ディスク用のエレクトロクロミック素子に関する研究  
 … (大阪産大工\*1・奥田技術事務所\*2) °長峯優治\*1・青木孝憲\*1・松下辰彦\*1・鈴木晶雄\*1・奥田昌宏\*2
- 5P-49 反射波面補正のためにイオンリングした軟 X 線多層膜鏡の評価  
 ……………… (東北大多元物質科学研) °梅津裕生・酒井 優・津留俊英・山本正樹

休 憩

A 会場 午後の部

口頭発表 V 【ナノ構造】 15:15~17:45

- 5Ap-1 【特別講演】  
 透過電子顕微鏡による原子選択イメージング…………… (物材機構) 木本浩司
- 5Ap-2 ダイヤモンド微粒子からの電界放射の表面熱処理による特性の変化  
 ……………… (東大院機能システム\*1・\*2東洋大バイオナノ\*2・東京大生産研\*3)  
 °油井寿徳\*1・吉本智巳\*1,\*2・岩田達夫\*3
- 5Ap-3 異なるゲート・エミッタ構造を有するシリコン電界放出電子源から放出される電子ビームの減速特性の差異  
 ……………… (京大院工\*1・中部大工\*2・日新イオン機器\*3)  
 °後藤康仁\*1・酒井善基\*1・河崎道人\*1・辻 博司\*1・石川順三\*2・酒井滋樹\*3
- 5Ap-4 一次元に配列した金微粒子からの第二高調波発生の研究  
 ……………… (横浜国大工\*1・FHI\*2・ベルリン自由大\*3・防衛大\*4)  
 °工藤雅史\*1・宮森麻理子\*1・島田 透\*2,\*3・北島正弘\*4・田中正俊\*1・鈴木隆則\*4

休 憩

- 5Ap-5 【特別講演】  
 CNT-FET を用いたバイオセンサー…………… (大阪大産研) 松本和彦
- 5Ap-6 低圧 CVD 法による高品質カーボンナノチューブ成長…………… (三重大院工) °南 智之・佐藤英樹
- 5Ap-7 化学気相成長法によるカーボンナノチューブアレイ構造の形成  
 ……………… (三重大院工\*1・名古屋大院工\*2) °森下逸平\*1・佐藤英樹\*1・齋藤弥八\*2

B 会場 午後の部

口頭発表 VI 【薄膜 II ・表面工学】 15:15~17:45

- 5Bp-1 回転型低温 6 元対向スパッタ装置の開発と作製した Nb 及び Ta 薄膜の膜質…………… (山口大院理工) 諸橋信一
- 5Bp-2 誘導結合プラズマ支援型多重磁極マグネトロンスパッタ法により作製した Cu 薄膜に及ぼす基板バイポーラ電  
 圧の効果…………… (広島工大\*1・トーヨーエイテック(株)\*2)  
 °森重史也\*1・大谷和輝\*1・笠井聖史\*1・川畑敬志\*1・岡本圭司\*2
- 5Bp-3 酸化チタンスパッタ膜微細構造における熱処理効果と水素検出特性  
 ……………… (富山大理工教育) °長田康彦・山崎登志成・喜久田寿郎
- 5Bp-4 【特別講演】  
 ハーフメタル薄膜の作成と応用…………… (物材機構) 古林孝夫

休 憩

- 5Bp-5 小型グロー放電装置を用いたアクリル樹脂等 MEMS 材料の親水化  
 ……………… (北海道大工研科\*1・SSIL\*2) °中山伸弘\*1・信太祐二\*1・山内有二\*1・日野友明\*1・西川正名\*2

- 5Bp-6 エアロゾルデポジション法による ZnS 皮膜創製のためのプロセス条件の最適化  
 ..... (豊橋技大生産システム工) °西村悠吾・山田基宏・福本昌宏
- 5Bp-7 【特別講演】  
 常温接合法の開発と微細接合への応用..... (東京大) 須賀唯知

—11月6日(金)—

A会場 午前の部

口頭発表Ⅶ【表面科学Ⅰ・応用表面科学】 9:00~12:00

- 6Aa-1 SiO<sub>2</sub>/Si(100)界面の振動分光: Si-O-Si 伸縮振動のピーク解析  
 ..... (産総研) °中村 健・黒河 明・野中秀彦・一村信吾
- 6Aa-2 反射分光による Si(001)表面における酸化過程と酸窒化過程の比較検討  
 ..... (横浜国大工\*1・防衛大理工\*2) °大野真也\*1・落合俊之\*1・鈴木隆則\*2・首藤健一\*1・田中正俊\*1
- 6Aa-3 酸化 Ti/Si 表面ナノ構造の STM/STS 測定  
 ..... (横浜国大工) °青木健志・首藤健一・佐藤和成・大野真也・田中正俊
- 6Aa-4 UV ランププロセスでの Silver-QCM の表面酸化挙動の解明  
 ..... (岩崎電気\*1・産総研\*2・金沢大院自然研\*3)  
 °松本裕之\*1,\*3・松岡幹彦\*1・吉野潔\*1・岩崎達行\*1・木下 忍\*1・野田和俊\*2・岩森 暁\*3
- 6Aa-5 低エネルギーイオンビーム照射装置を用いたシリカ基板へのインジウムおよびガリウムの注入  
 ..... (大阪大工\*1・産総研\*2) °吉村 智\*1・塚崎泰裕\*1・木内正人\*1,\*2・浜口智志\*1
- 休 憩
- 6Aa-6 電解液溶媒を吸着させた Li イオン二次電池用黒鉛負極材料のガス放出挙動  
 ..... (北海道大院工\*1・日立粉末冶金\*2)  
 °渡邊俊智\*1・信太祐二\*1・山内有二\*1・日野友明\*1・久保田良博\*2・大関克知\*2
- 6Aa-7 酸化物-金属界面終端の熱力学 ..... (物材機構) °吉武道子・Kim Teayoung・Slavomir Nemsak
- 6Aa-8 Cu(111)上 C<sub>60</sub> 単分子層の電子状態の吸着構造依存性 ..... (筑波大数理物質\*1・イデアルスター\*2)  
 °加藤恵介\*1・中山拓人\*1・才田守彦\*2・表研次\*2・横尾邦義\*2・山田洋一\*1・佐々木正洋\*1
- 6Aa-9 格子歪による  $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ -Ag 表面の電子状態の変化 ..... (横浜市大国際総合) °望月出海・根岸良太・重田諭吉
- 6Aa-10 【特別講演】  
 Si 系薄膜の成膜機構の原子・分子レベルでの解明と低温・高品質形成を実現する新たな成膜技術の創生  
 ..... (東北大電通研) 末光眞希

休 憩

B会場 午前の部

口頭発表Ⅷ【薄膜Ⅲ】 9:00~12:00

- 6Ba-1 Microstructure of WO<sub>3</sub> sputtered films deposition under various gas pressure  
 ..... (富山大理工教育) T. Yamazaki, °N. M. Shaalan, T. Kikuta and T. Kawabata
- 6Ba-2 RF マグネトロンスパッタ法によるフレキシブル BaTiO<sub>3</sub> 薄膜の作製と評価  
 ..... (鳥取県産技センター\*1・鳥取大工\*2・鳥取大工電子ディスプレイ研究センター\*3)  
 °吉田大一郎\*1,\*2・出口恭平\*2・高橋智一\*1・木下健太郎\*2,\*3・大観光徳\*2,\*3・岸田 悟\*2,\*3
- 6Ba-3 ヘリコンプラズマスパッタリング法により作製したセリウム酸バリウム電解質を用いた薄型燃料電池の低温作動特性 ..... (大阪工大) °吉村祐太郎・新田智紀・長田昭義
- 6Ba-4 光電子制御プラズマ CVD による SiO<sub>2</sub> 基板への多層グラフェン成長  
 ..... (東北大多元研\*1・CREST-JST\*2・富士通\*3)  
 °小川修一\*1,\*2・角 治樹\*1・佐藤元伸\*2,\*3・二瓶瑞久\*2,\*3・高桑雄二\*1,\*2
- 6Ba-5 アルミナ膜を応用したプロトン伝導形燃料電池の室温作動特性  
 ..... (大阪工大工電気電子システム) °野阪英彦・吉村祐太郎・平野 俊・長田昭義
- 6Ba-6 【特別講演】  
 放射光を用いた光電子分光による半導体プロセスにおける薄膜成長の解析..... (東京大学) 尾嶋正治
- 6Ba-7 大面積透明フレキシブル GZO-ReRAM の作製と評価  
 ..... (鳥取大\*1・尾池工業\*2・鳥取大電子ディスプレイ研究センター\*3)  
 °田中隼人\*1・奥谷 匠\*1・牧野達也\*1・檜木利雄\*1,\*2・大観光徳\*1,\*3・木下健太郎\*1,\*3・岸田 悟\*1,\*3

- 6Ba-8 透明 GZO-ReRAM の抵抗変化メカニズム  
 ..... (鳥取大\*1・尾池工業\*2・鳥取大電子ディスプレイ研究センター\*3)  
 °奥谷 匠\*1・田中隼人\*1・牧野達也\*1・檜木利雄\*1,\*2・大観光徳\*1,\*3・木下健太郎\*1,\*3・岸田 悟\*1,\*3
- 6Ba-9 NiO-ReRAM におけるフィラメントパスの分析  
 ..... (鳥取大工\*1・鳥取大院工\*2・鳥取大工電子ディスプレイ研究センター\*3)  
 °依田貴稔\*1・木下健太郎\*2,\*3・土橋一史\*2・牧野達也\*2・岸田 悟\*2,\*3
- 6Ba-10 酸化ニッケルスパッタ膜の多孔性評価と NO<sub>2</sub> 検出特性  
 ..... (富山大院理工教育) °米澤正隆・山崎登志成・喜久田寿郎

休 憩

A 会場 午後の部

口頭発表Ⅸ【表面科学Ⅱ】 13:00~15:30

- 6Ap-1 【特別講演】  
 グラファイト表面上の単原子層 Pt 触媒 ..... (筑波大) 近藤剛弘
- 6Ap-2 D+D<sub>2</sub>O/Ru 供吸着表面からの水素引き抜き反応 ..... (九州工大) °山内貴志・嶺 和幸・並木 章
- 6Ap-3 水素-Si(100)表面における Detailed Balance の再度の破れ  
 ..... (山形大院工\*1・九工大院工\*2) °成田 克\*1・稲永征司\*2・並木 章\*2
- 6Ap-4 光励起熱脱離法 (LITD 法) による物理吸着水素分子の表面拡散の測定  
 ..... (東京大生産研) °池田暁彦・松本益明・小倉正平・福谷克之・岡野達雄

休 憩

- 6Ap-5 Ag(111)表面における酸素分子の吸着状態 ..... (東京大生産研) °風間吉則・杉本敏樹・松本益明・福谷克之
- 6Ap-6 酸素吸着 Ti/Si 表面における高温酸化状態の面方位依存性 ..... (横浜国大工\*1・東京大物性研\*2)  
 °市川雄一\*1・島津知彦\*1・大野真也\*1・首藤健一\*1・原沢あゆみ\*2・柿崎明人\*2・田中正俊\*1
- 6Ap-7 水とメタンが共吸着した希ガス固体表面上からの光励起脱離  
 ..... (学習院大理) °松本大吾・萩谷昭洋・村井晴香・三浦 崇・荒川一郎
- 6Ap-8 Si(111)上に吸着させた CF<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH の電子-イオンコインシデンス分光 (PEPICO) 測定  
 ..... (横浜国大院工\*1・KEK 物構研\*2) °山崎貴彦\*1・橋本章吾\*1・間瀬一彦\*2・田中正俊\*1

閉会式 15:30~

B 会場 午後の部

口頭発表Ⅹ【薄膜Ⅳ・電子材料・プロセス】 13:00~15:30

- 6Bp-1 紫外光励起オゾンによる Si 酸化膜および CVD-SiO<sub>2</sub> 膜の二段階酸化膜の界面特性評価  
 ..... (榊明電舎\*1・産総研\*2)  
 °亀田直人\*1,\*2・西口哲也\*1,\*2・森川良樹\*1・花倉 満\*1・野中秀彦\*2・一村信吾\*2
- 6Bp-2 半導体デバイス解析用局所プラズマ加工装置 ..... (榊三友製作所\*1・産総研\*2)  
 °新堀俊一郎\*1・白山裕也\*1・川上辰男\*1・横須賀俊太郎\*1・樫村健太\*1・清水哲夫\*2・内藤泰久\*2・徳本洋志\*2
- 6Bp-3 イオンビーム空間電荷中和実験のための大電流極低エネルギーイオン源の試作  
 ..... (京大院工\*1・日新イオン機器\*2・中部大工\*3)  
 °田口周平\*1・後藤康仁\*1・辻 博司\*1・酒井滋樹\*2・石川順三\*3
- 6Bp-4 【特別講演】  
 CIGS 系太陽電池の開発 ..... (産総研) 石塚尚吾

休 憩

- 6Bp-5 有機太陽電池用の発電層のナノ構造制御 ..... (愛工大工電気) 落合鎮康
- 6Bp-6 低真空環境における有機フォトリソミック膜表面での微細メタル結晶成長  
 ..... (大阪教育大教養) °岩井勇輔・瀬角祐介・辻岡 強
- 6Bp-7 Optical Bistability of Poly (3-octylthiophene) /Polymethylmethacrylate Composite Waveguides Prepared by Spin Coating ..... (Dept. of Electrical Eng., Aichi Inst. of Tech.)  
 °Jayaraman Ramajothi・Kenzo Kojima・Teruyoshi Mizutani・Shizuyasu Ochiai
- 6Bp-8 有機薄膜研究用高輝度真空紫外軟 X 線ビームラインの開発  
 ..... (KEK 物構研) 豊島章雄・菊地貴司・田中宏和・°間瀬一彦・雨宮健太・伊藤健二

## 発表者へのご案内

### 1. 口頭発表

講演時間は15分（討論時間5分を含む）です。講演時に使用可能な機材は液晶プロジェクタ（HP vp6325-対応解像度：VGA/SVGA/XGA/XGA+/SXGA/SXGA+、接続コネクタ：mini D-Sub15pin）のみです（ノートパソコンは持参ください）。コンピュータ持参不可の場合や、機器故障、不調の場合を考慮して、各会場に発表用のパソコン（HP 6730b-Windows Vista Enterprise SP1）を用意いたします。ただし、会場のパソコンを使用する場合は必ずPDF形式のファイルをご準備ください。USBメモリーでのデータ持参をお願いいたします。休憩時間やセッション開始前にファイルの動作確認をお願いいたします。

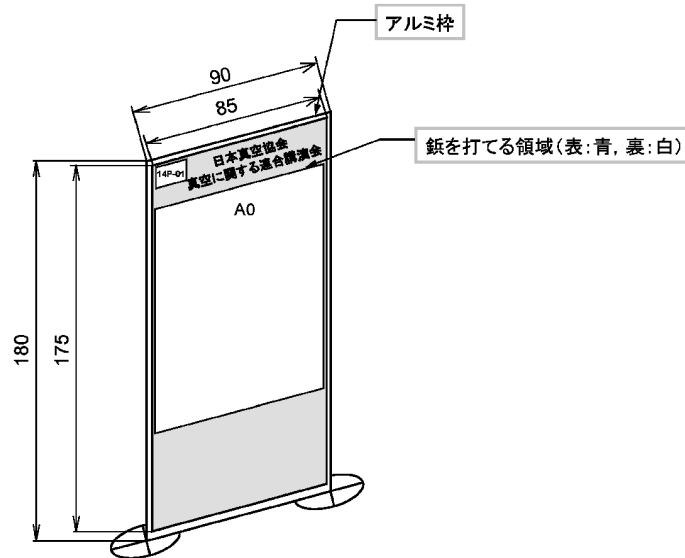
### 2. ポスター発表

ポスター展示時間は下の表の通りです。コアタイムではポスターの前で説明をお願いいたします。パネルの大きさは下図のように縦175 cm×横85 cmです。パネル左上に縦10 cm×横20 cmの余白をとってください。余白に事務局で発表番号を貼ります。ポスター貼り付けには押しピンのみ使用可能です。押しピンは会場にて用意いたします。

	11月4日（水）	11月5日（木）
展示開始	12：00	12：00
コアタイム（奇数）	14：00-15：00	13：00-14：00
コアタイム（偶数）	15：00-16：00	14：00-15：00
撤収開始	17：00	17：00

#### ●ポスターボード概略図●

単位：cm



### 3. 優秀ポスター投票と発表

ポスターセッション開催中に参加票添付の投票用紙にて優秀ポスターの投票をお願いいたします。投票箱はポスター会場入り口付近に設置します。投票締切りは11月5日（木）15：30です。結果の発表は16：30頃に3F受付付近で行う予定です。皆様のご協力をお願いいたします。表彰は懇親会場（学習院輔仁会館2階さくらラウンジ）にて行います。

## 会場案内図

JR 山手線「目白駅」より徒歩1分です。大学構内及び周辺には利用できる駐車場がありませんので、自動車でのご来場は固くお断りいたします。

